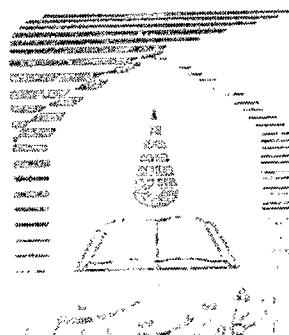


A highly stylized, cursive black ink signature or calligraphy on a white background. The strokes are fluid and expressive, forming abstract shapes and loops. There are several small, solid black dots scattered across the surface, notably one near the center-right and another towards the bottom right.

J. Ma.

۱۳۸۶

۱۷/۱/۱۹۸۶



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مهندسی برق - مخابرات (میدان و امواج)

طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر با ابعاد کوچک بوسیله DGS

محسن گلپور دهسری

استاد راهنمای:

دکتر کیوان فرورقی

اسفند ماه ۱۳۸۶

الف

۱۰۸۸۹۰



بسم الله الرحمن الرحيم

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان

آقای محسن گل پور دهسری پایان نامه ۹ واحدی خود را با عنوان طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر با ابعاد کوچک بوسیله DGS در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ ارائه کردند.
اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	دانشیار	دکتر کیوان فرورقی	استاد راهنما
استاد مشاور	استاد دیار	دکتر زهرا اطلس باف	
استاد ناظر	استاد	دکتر محمد حکاک	
استاد ناظر	دانشیار	دکتر منوچهر کامیاب	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	استاد	دکتر محمد حکاک	

این نسخه به عنوان نسخه اولیه پایان نامه / رساله در دست تأیید است.

امضا از استاد راهنما:

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله)‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله)‌ی خود، مراتب را قبلًا به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته **برنامه** است که در سال ۱۳۸۶ در دانشکده **فنی تحقیقی** دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر **هزارمی خردروانی** و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر **رُهْرَه طالبی باز** از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می‌تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درعرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقيف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب **حسن طبری** دانشجوی رشته **برنامه** مقطع کارشناسی ارشد.

تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شوم.

نام و نام خانوادگی:

حسن طبری

تاریخ و امضا:

۸۷/۱/۱۸

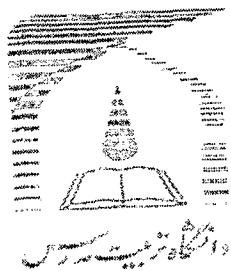
حسن طبری

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی

دانشگاه تربیت مدرس

با عنايت به سياست‌های پژوهشي و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و كرامت انسانهاكه شکوفايي علمي و فني است و رعایت حقوق مادي و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضاي علمي، دانشجويان، دانشآموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمي که تحت ن پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت :

- ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌باشد ولی معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.
- ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در محفل علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنمای، مشاور و یا چوی مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده راهنمای و دانشجو می‌باشد.
- ۳- در مقالاتی که پس از دانشآموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.
- ۴- انتشار كتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای اتي کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده‌ها، مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، پارک علم و فناوری و واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین‌نامه‌های مصوب شود.
- ۵- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که ل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنمایی طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
- ۶- آئین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴/۸/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در رئیسه دانشگاه به تایید رسیده و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

مهندسی برق- مخابرات (میدان و امواج)

طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر با ابعاد کوچک بوسیله **DGS**

محسن گلپور دهسری

استاد راهنمای:

دکتر کیوان فرورقی

استاد مشاور:

دکتر زهرا اطلسی باف

اسفند ماه ۱۳۸۶

تشکر و قدردانی:

بدین وسیله از زحمات استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرورقی که مسئولیت راهنمایی و نظارت بر این پایان نامه را برعهده گرفته و در کلیه مراحل تحقیق و تدوین آن اینجانب را راهنمایی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان را در همه شئون زندگی از خداوند بزرگ خواستارم.

از دوست عزیزم جناب آقای مهندس حمیدرضا دلیلی اسکوئی که در انجام این تحقیق اینجانب را یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم و برای ایشان آرزوی سعادت و موفقیت دارم.

محسن گلپور دهسری

چکیده:

در این تحقیق به معرفی ساختارهای DGS¹ پرداخته شد با توجه به پروسه ساخت آسان و قابلیت مجتمع شدن با سایر ادوات مایکروویاين ساختارها مورد توجه هستند. در این تحقیق با توجه به اینکه در مراجع مختلف انواع این ساختارها ارایه و تحلیل و مورد استفاده قرار گرفته اند، سعی شده با استفاده از همان ساختارها و بدون وارد شدن به مقوله ارایه یک ساختار جدید، یک فیلتر با مشخصه بهبود یافته و حتی الامکان کوچک، طراحی و ساخته شود. که در نهایت با استفاده از DGS دمبل شکل توانستیم یک فیلتر پایین گذر بدون ریپل در باند عبور و با شبیه حذف تند و پنهانی باند حذف خوب طراحی کنیم.

این تحقیق در شش فصل ارایه شده است. در فصل اول به معرفی این ساختارها می پردازد. در فصل دوم به ارایه مدار معادل، تحلیل شبکه و بررسی باند حذف و عبور در این ساختارها پرداخته شد. در فصل سوم به بررسی اثر چرخش بر روی مشخصه فرکانسی دو نوع DGS پرداخته شد که اولی از نوع مستطیلی و دومی از نوع دمبل شکل بود. استفاده از شبکه های عصبی مورد توجه قرار گرفت که در نهایت با استفاده از شبکه MLP این عمل انجام شد.

در فصل چهارم به بررسی اثرات تغییر ابعاد فیزیکی پرداخته شد که در هر مورد با توجه به پارامترها نتایج ارایه شدند.

در فصل پنجم روند طراحی یک فیلتر پایین گذر از ابتدا تا حصول نتیجه مطلوب ارایه شد که در همین فصل پارامتر ضریب شبیه معرفی و برای مقایسه بین چند فیلتر مورد استفاده قرار گرفت. در فصل ششم به منظور رسیدن به یک روند طراحی با استفاده از DGS دمبل شکل، به بررسی اثر تغییرات ارتفاع زیر لایه و ثابت دی الکتریک بر روی پارامترهای فرکانس رزونانس و فرکانس قطع 3dB پرداخته شد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	۱- مقدمه
۹	۲- مدار معادل و تحلیل شبکه
۹	۳-۱- مدار معادل و تحلیل شبکه
۱۴	۳- بررسی اثرات چرخش DGS بر مشخصه خط انتقال
۲۲	۳-۱-۳- مدل عصبی چرخش : DGS
۲۲	۳-۲- شبکه MLP
۲۳	۳-۳- ویژگی تعمیمدهی MLP
۳۰	۴- بررسی اثر چرخش بر روی DGS دمبل شکل
۴۴	۴- بررسی اثرات تغییرات پارامترهای فیزیکی DGS بر روی مشخصه
۴۴	۴-۱- بررسی تغییرات مشخصه DGS مستطیلی شکل با تغییر ابعاد (s,d)
۴۵	۴-۱-۱- اثر عرض شکاف (s)
۴۶	۴-۱-۲- بررسی اثر تغییر طول شکاف (d)
۴۷	۴-۲- بررسی اثرات تغییرات پارامتر های فیزیکی DGS دمبل شکل دایروی (d,s,r)
۴۷	۴-۲-۱- بررسی اثر تغییر شعاع دایره (r)
۴۸	۴-۲-۲- بررسی اثر تغییرات عرض شکاف (s)
۴۹	۴-۲-۳- بررسی اثر تغییر طول (d)
۵۰	۴-۳- بررسی اثرات تغییر پارامترهای فیزیکی در DGS دمبل شکل مربعی (d,s,a)
۵۱	۴-۳-۱- بررسی اثر تغییرات در پارامتر (a)
۵۲	۴-۳-۲- بررسی اثر تغییر عرض شکاف (s)
۵۳	۴-۳-۳- بررسی اثر تغییرات طول (d)

- ۴-۴- برسی اثرات تغییرات پارامترهای فیزیکی DGS دمبل شکل مثلثی (a,d,s)
- ۵۴ _____ ۱-۴- برسی اثر تغییرات پارامتر a
- ۵۵ _____ ۵-۴- برسی اثر تغییر عرض شکاف (S)
- ۵۶ _____ ۶-۴- برسی اثر تغییر پارامتر (d)
- ۵۷ _____ ۷- طراحی فیلتر پایین‌گذر با استفاده از DGS
- ۶۲ _____ ۸- چرخش DGS
- ۶۸ _____ ۹- استفاده از استاب مدار باز یک طرفه با چرخش DGS
- ۶۹ _____ ۱۰- شبیه سازی فیلتر های طراحی شده در مرجع [1]
- ۷۰ _____ ۱۱- برسی اثر اضافه کردن استاب دو طرفه بر روی خط میکرواستریپ و در بالای DGS
- ۷۲ _____ ۱۲- استخراج مدار معادل:
- ۷۳ _____ ۱-۵- تغییر طول و ثابت نگه داشتن عرض
- ۷۶ _____ ۲-۵- تغییر عرض و ثابت نگه داشتن طول
- ۷۷ _____ ۱۳- برسی اثر چرخش DGS در حالتی که استاب مدار باز وجود دارد.
- ۷۸ _____ ۱۴- طراحی فیلتر
- ۷۹ _____ ۱۵- برسی اثر تغییر ثابت دی الکتریک و ارتفاع دی الکتریک بر مشخصه DGS
- ۱۹ _____ ۱۶- برسی اثر تغییر ثابت دی الکتریک و ارتفاع دی الکتریک بر مشخصه DGS
- ۹۲ _____ ۱۷- طراحی DGS هنگامی که پارامترهای زیر لایه تغییر کنند

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۵.....	جدول (۱): پارامترهای بدست آمده از نتایج شبیه سازی
۱۶.....	جدول (۲): پارامترهای مدار معادل
۱۹.....	جدول (۳): پارامترهای بدست آمده از شبیه سازی
۱۹.....	جدول (۴): پارامترهای مدار معادل
۲۶.....	جدول (۵): پارامترهای چند زاویه دلخواه برای تست شبکه
۲۶.....	جدول (۶): پارامترهای مدار معادل زوایای انتخابی برای تست شبکه
۳۱.....	جدول (۷): پارامترهای استخراج شده برای DGS دمبل شکل
۳۱.....	جدول (۸): پارامترهای مدار معادل برای DGS دمبل شکل
۳۴.....	جدول (۹): پارامترهای بدست آمده از شبیه سازی برای تست شبکه
۳۵.....	جدول (۱۰): پارامترهای مدار معادل برای تست شبکه
۴۵.....	جدول (۱۱): پارامترهای DGS مستطیل شکل با تغییر S
۴۶.....	جدول (۱۲): پارامترهای DGS مستطیل شکل با تغییر D
۴۸.....	جدول (۱۳): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر دایروی با تغییر R
۴۹.....	جدول (۱۴): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر دایروی با تغییر S
۵۰.....	جدول (۱۵): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر دایروی با تغییر D
۵۱.....	جدول (۱۶): پارامترهای DGS دمبل مانند مریعی با تغییر A
۵۲.....	جدول (۱۷): پارامترهای DGS دمبل مانند مریعی با تغییر S
۵۳.....	جدول (۱۸): پارامترهای DGS دمبل مانند مریعی با تغییر D

جدول (۱۹): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر مثلثی با تغییر A	۵۵.....
جدول (۲۰): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر مثلثی با تغییر S	۵۶.....
جدول (۲۱): پارامترهای DGS دمبل شکل با سر مثلثی با تغییر D	۵۷.....
جدول (۲۲): پارامترهای مربوط به طراحی فیلتر HI-Z & LOW-Z	۶۶.....
جدول (۲۳): پارامترهای مربوط به بررسی اثر تغییر طول استاب	۷۷.....
جدول (۲۴): پارامترهای مربوط به بررسی اثر تغییر عرض استاب	۷۸.....
جدول (۲۵): عرض خطوط میکرواستریپ ۵۰ Ω برای ثابت‌های دی‌الکتریک و ارتفاع‌های متفاوت (ابعاد به میلی متر)	۸۹.....
جدول (۲۶): پارامترهای شبیه‌سازی شده برای ثابت دی‌الکتریک متفاوت و ارتفاع‌های مختلف	۹۰.....

فهرست شکلها

صفحه	عنوان
۳	شکل (۱): چند نمونه از ساختارهای DGS متداول
۴	شکل (۲): یک خط انتقال میکرواستریپ به همراه DGS مستطیل شکل
۴	شکل (۳): S11 خط معمولی و DGS دار
۵	شکل (۴): S21 خط معمولی و DGS دار
۵	شکل (۵): توزیع جریان خط DGS دار
۹	شکل (۶): یک سلوول DGS به همراه مدار معادل
۱۱	شکل (۷): نمودار $\cos(\beta d)$ بر حسب فرکانس
۱۲	شکل (۸): پارامترهای پراکندگی خط DGS دار
۱۴	شکل (۹): مدار معادل DGS
۱۴	شکل (۱۰): نمای DGS مستطیلی
۱۶	شکل (۱۱): نمودار تغییرات سلف مدار معادل بر حسب تغییرات زاویه
۱۷	شکل (۱۲): نمودار تغییرات خازن مدار معادل بر حسب چرخش
۱۷	شکل (۱۳): نمودار تغییرات فرکانس قطع 3DB
۱۸	شکل (۱۴): نمودار تغییرات فرکانس رزونانس بر حسب چرخش
۲۰	شکل (۱۵): نمودار تغییرات فرکانس رزونانس بر حسب درجه چرخش
۲۰	شکل (۱۶): نمودار تغییرات فرکانس قطع 3DB بر حسب درجه چرخش
۲۱	شکل (۱۷): نمودار تغییرات مقدار خازن مدار معادل بر حسب درجه چرخش
۲۱	شکل (۱۸): نمودار تغییرات مقدار سلف مدار معادل بر حسب زاویه چرخش
۲۳	شکل (۱۹): نمای کلی یک شبکه سه لایه
۲۵	شکل (۲۰): نمودار کاهش خطای خروجی بر حسب تعداد دفعات آموزش شبکه

شکل (۲۱): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (S21) ۲۷
شکل (۲۲): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (S11) ۲۷
شکل (۲۳): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (فرکانس فرکانس (3DB ۲۸
شکل (۲۴): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (فرکانس رزونانس) ۲۸
شکل (۲۵): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (سلف مدار معادل) ۲۹
شکل (۲۶): نمودار خروجی‌ها شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (خازن مدار معادل) ۲۹
شکل (۲۷): خروجی شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (مقاومت مدار معادل) ۳۰
شکل (۲۸): نمای سه بعدی یک DGS دمبل شکل ۳۰
شکل (۲۹): نمودار تغییرات مقدار خازن مدار معادل بر حسب زاویه چرخش ۳۲
شکل (۳۰): نمودار تغییرات مقدار سلف مدار معادل بر حسب زاویه چرخش ۳۲
شکل (۳۱): نمودار تغییرات فرکانس رزونانس بر حسب زاویه چرخش ۳۳
شکل (۳۲): نمودار تغییرات فرکانس 3DB بر حسب زاویه چرخش ۳۳
شکل (۳۳): نمودار کاهش خطأ در فرآیند آموزش شبکه عصبی بر حسب تعداد دفعات آموزش ۳۴
شکل (۳۴): نمودار خروجی شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (S21) ۳۵
شکل (۳۵): نمودار خروجی شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (پارامتر S11 ۳۶
شکل (۳۶): نمودار خروجی شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (فرکانس قطع 3DB ۳۶
شکل (۳۷): نمودار خروجی شبکه برای زوایای تست و مقادیر شبیه‌سازی شده متناظر (فرکانس رزونانس) ۳۷
شکل (۴۲): DGS های دو دسته و پارامترهای ابعادی متناظر ۴۴

۴۴	شکل (۴۳): یک DGS مستطیل شکل.....
۴۶	شکل (۴۴): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف S
۴۷	شکل (۴۵): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف D
۴۷	شکل (۴۶): دمبل شکل با سر دایروی
۴۸	شکل (۴۸): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف R
۴۹	شکل (۴۹): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف S
۵۰	شکل (۵۰): پارامترهای مدار معادل مقادیر مختلف D
۵۱	شکل (۵۱): شکل DGS دمبل مانند مریعی.....
۵۲	شکل (۵۲): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف A
۵۳	شکل (۵۳): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف S
۵۴	شکل (۵۴): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف D
۵۴	شکل (۵۵): دمبل شکل با سر مثلثی.....
۵۵	شکل (۵۶): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف A
۵۶	شکل (۵۷): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف S
۵۷	شکل (۵۸): پارامترهای مدار معادل برای مقادیر مختلف D
۶۴	شکل (۵۹): مدار اصلاح شده برای DGS در باند عبور.....
۶۶	شکل (۶۰): پاسخ فرکانسی فیلتر طراحی شده با روش HI-Z & LOW-Z
۶۷	شکل (۶۱): مشخصه S11 و S21 برای DGS دمبل شکل با سر مربعی
۶۸	شکل (۶۲): مشخصه S11 و S21 برای چرخش DGS
۶۹	شکل (۶۳): شکل استاب مدار باز یک طرفه با DGS
۶۹	شکل (۶۴): مشخصه S11 و S21 استاب مدار باز یک طرفه و DGS
۷۰	شکل (۶۵): طرحهای استفاده شده درمرجع [1]
۷۱	شکل (۶۶): نتایج شبیه‌سازی شکل A
۷۱	شکل (۶۷): نتایج شبیه‌سازی شکل B

شکل (۶۸): دمبل شکل و استاب مدار باز دو طرفه.....	۷۲
شکل (۶۹): نتیجه شبیه‌سازی برای DGS دمبل شکل و استاب مدار باز.....	۷۳
شکل (۷۰): مدار معادل پیشنهادی برای DGS دمبل شکل و استاب مدار باز.....	۷۳
شکل (۷۱): مدار فیلتر باترورث با دوفر کانس رزونانس.....	۷۴
شکل (۷۲): نمودار شبیه‌سازی EM و مدار معادل پیشنهادی برای DGS و استاب.....	۷۶
شکل (۷۳): نتایج شبیه‌سازی EM برای DGS عادی و DGS زاویه دار با استاب.....	۷۹
شکل (۷۴): شکل دو و احد DGS زاویه دار و استاب مدار باز که به طور متواالی قرار دارند.....	۸۰
شکل (۷۵-الف): مقایسه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی برای پارامتر S11.....	۸۰
شکل (۷۵-ب): مقایسه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی برای پارامتر S21.....	۸۱
شکل (۷۶): نمای روی مدار ساخته شده.....	۸۱
شکل (۷۷): نمای پشت مدار ساخته شده.....	۸۱
شکل (۷۸-الف): مقایسه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی برای پارامتر S11.....	۸۲
در شکل (۷۸-ب): مقایسه نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی برای پارامتر S21.....	۸۳
شکل (۷۹): نمای رو مدار ساخته شده.....	۸۳
شکل (۷۹): نمای پشت مدار ساخته شده.....	۸۳
 شکل (۸۰): شکل DGS دمبل شکل.....	۸۹
شکل (۸۱): فرکانس رزونانس بر حسب ثابت دیالکتریک برای ارتفاعهای مختلف.....	۹۱
شکل (۸۲): S21 بر حسب ثابت دیالکتریک برای ارتفاعهای مختلف.....	۹۲
شکل (۸۳): تصحیح فرکانس رزونانس بر حسب ثابت دیالکتریک برای ارتفاعهای مختلف.....	۹۳
شکل (۸۴): فرکانس رزونانس و فرکانس قطع بر حسب تغییرات.....	a ۹۵
شکل (۸۵): فرکانس رزونانس و فرکانس قطع بر حسب تغییرات.....	S ۹۶
شکل (۸۶): فرکانس رزونانس و فرکانس قطع بر حسب تغییرات.....	d ۹۶

فصل اول

مقدمه

۱- مقدمه

خطوط انتقال میکرواستریپ بخاطر سادگی در پروسه ساخت و اجرا بطور گستردگی در مدارات مختلف مایکروویو در محدوده فرکانسی وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خطوط برای ساختن فیلترها و کوپلرها و ... در توانهای پایین براحتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیلترهای با ابعاد کوچک و مشخصه حذف خوب در بسیاری از سیستمهای مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فیلترها را می‌توان با ساختارهای گوناگون طراحی و پیاده‌سازی کرد. از میان روش‌های گوناگون طراحی فیلترها یکی از روش‌هایی که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از DGS ها است. به دلیل اینکه این ساختارها ابعاد کوچک و شکل ساده‌ای دارند در ساخت فیلترهای پایین گذر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند دلیل دیگر گرایش به این ساختارها در طراحی فیلتر مشخصه عبور بدون ریپ و مشخصه حذف تیز با تضعیف زیاد می‌باشد. کاربردهای زیر به عنوان کاربردهای فیلترهای پایین گذر به طور عمدۀ ذکر شده است:

خروجی نوسان‌سازها برای حذف هارمونیکهای تولید شده ناشی از غیر خطی بودن .
خروجی میکسرها برای عبور فرکانس IF.

وروپی گیرندها برای حذف فرکانس‌های ناخواسته بالاتر
ترکیب با یک فیلتر بالاگذر برای درست کردن یک BPF

در ساده ترین تعریف DGS Slotها میکرواستریپ قرار دارند برای ساخت DGS فلز سطح زمین به شکل مورد نظر از سطح زمین مدارات میکرواستریپ برداشته می‌شود. این مقدار فلز برداشته شده از سطح زمین مدار میکرواستریپ با ید در مقایسه با ابعاد زمین به قدری باشد که تعریف زمین مدار میکرواستریپ هنوز برقرار باشد. این قسمت برداشته شده از سطح زمین توزیع جریان و میدان الکتریکی را دچار تغییر کرده و میدانها در آن قسمتی که فلز ندارد به شکل دیگری آرایش می‌یابند. این تغییرات باعث می‌شود که خط میکرواستریپ رفتار متفاوتی در مقایسه با حالت عادی از خود نشان دهد. این رفتار خط میکرواستریپ در حضور DGS در مرجع [1] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به پاسخ فرکانسی ، برای آن مدار معادل ارایه شده است که این مدار معادل یک تشدید - گر LC موازی بوده که مقادیر L و C از روی نتایج شبیه سازی EM استخراج شده اند.

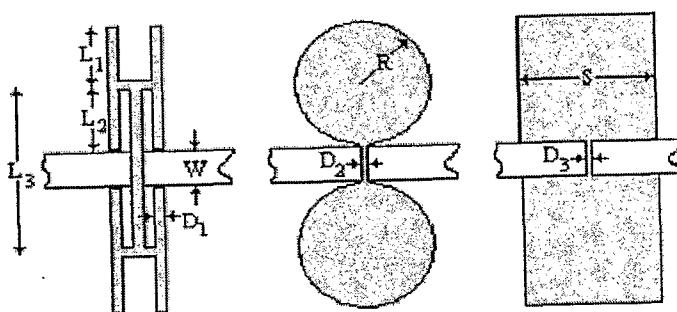
این ساختارها در گروه ساختارهای Slow Wave دسته‌بندی شده و خاصیت گزینش فرکانس را دارند و لذا می‌توان از آنها عنوان فیلتر استفاده کرد. فیلترهای گوناگونی در مراجع مختلف بوسیله این ساختارها ارایه ، شبیه سازی و ساخته شده است.[3,11,20].

مزیت‌های استفاده از DGS در طراحی فیلتر پایین گذر را در موارد زیر می‌توان یافت:

۱. ساختار بسیار ساده و کوچک و در نتیجه هزینه ساخت کمتر.

- ۱- باند توقف بسیار پهن با مقدار حذف بیشتر از ساختارهای متداول.
۲. تلف عبوری پایین‌تر از ساختارهای متداول دارند.
۳. مشخصه عبور بدون ریپل
۴. مشخصه حذف در حد فیلتر های بیضوی ولی بدون ریپل در باند عبور
۵. مشخصه حذف در حد فیلتر های بیضوی ولی بدون ریپل در باند عبور

یک DGS را در ساده‌ترین شکل به صورت یک Slot با شکل دلخواه روی صفحه زمین یک خط میکرواستریپ تعریف کردیم. هر شکل می‌تواند خواص فرکانسی متفاوتی با سایر اشکال داشته باشد. این رفتار متفاوت در فرکانسی که به عنوان فرکانس رزونانس مطرح می‌شود بروز می‌کند. در شکل (۱) چند نمونه از ساختارهای DGS را می‌بینید.



شکل (۱): چند نمونه از ساختارهای DGS متداول

برای اجرای DGS فلز سطح زمین به شکل موردنظر برمی‌دارند. هدف از ارایه شکلهای مختلف بدست آوردن مشخصه فرکانسی دلخواه است.

بطور کلی اثر یک DGS را می‌توان در دو دسته کلی زیر در نظر گرفت:
انتشار موج در باند عبور
تضعیف موج در فرکانس رزونانس

در مدلی که در فصل بعدی ارایه می‌شود این رفتار بیشتر شرح داده می‌شوند در محدوده فرکانسی می‌توان از تحلیل‌های EM برای مشاهده رفتار این ساختارها بهره گرفت. برای آشنایی بیشتر ابتدا به مقایسه پارامترهای دو خط انتقال مشابه یکی عادی و دومی DGS دار می‌پردازیم. در شکل (۲) یک خط انتقال را بهمراه یک DGS مستطیل شکل می‌بینید. خط انتقال دارای امپدانس 50Ω برای فرکانس 4GHz در نظر گرفته شده است. تحلیل خط میکرواستریپ بدون DGS را هم برای مقایسه انجام می‌دهیم. ابعاد DGS در این حالت 3mm×10mm است. زیر لایه از نوع با $\epsilon_r = 4.4$ و ارتفاع 1mm می‌باشد.